

請求の範囲

- [請求項1] 半導体基板またはガラス基板表面を洗浄するための洗浄液組成物であって、構造内にフッ素原子を含んだ無機酸またはその塩を1種または2種以上、水、還元剤を1種または2種以上、およびアニオン性界面活性剤を1種または2種以上含有し、かつ、水素イオン濃度（pH）が7未満である、前記洗浄液組成物。
- [請求項2] 構造内にフッ素原子を含んだ無機酸が、フッ化水素酸、ヘキサフルオロケイ酸もしくはテトラフルオロホウ酸またはこれらの組み合わせである、請求項1に記載の洗浄液組成物。
- [請求項3] フッ素原子を含んだ無機酸の塩が、アンモニウム塩、アミン塩もしくは第四級アンモニウム塩またはこれらの組み合わせである、請求項1に記載の洗浄液組成物。
- [請求項4] 還元剤が、2以上のヒドロキシル基を有する五員環または六員環化合物からなる群から選択される、請求項1～3のいずれか一項に記載の洗浄液組成物。
- [請求項5] 2以上のヒドロキシル基を有する五員環または六員環化合物が、アスコルビン酸、カテコール、レゾルシノール、ヒドロキノン、ピロガロールまたはメチルカテコールである、請求項4に記載の洗浄液組成物。
- [請求項6] アニオン性界面活性剤が、ナフタレンスルホン酸とホルムアルデヒドとの縮合物またはその塩である、請求項1～5のいずれか一項に記載の洗浄液組成物。
- [請求項7] セリウム化合物を砥粒としたスラリーを用いて、半導体基板またはガラス基板表面の化学的機械研磨（CMP）を行った際に、前記半導体基板またはガラス基板表面に残留したセリウム化合物を洗浄するための、請求項1～6のいずれか一項に記載の洗浄液組成物。
- [請求項8] 請求項1～7のいずれか一項に記載の洗浄液組成物用の原液組成物であって、10倍～1000倍に希釈することにより前記洗浄液組成

物を得るために用いられる、前記原液組成物。

[請求項9] セリウム化合物を砥粒としたスラリーを用いて半導体基板またはガラス基板表面の化学的機械研磨（CMP）を行い、次いで請求項1～7のいずれか一項に記載の洗浄液組成物を用いて前記半導体基板またはガラス基板表面に残留したセリウム化合物を洗浄する工程を含む、電子デバイスの製造方法。